

第三代半导体 SiC 晶体生长技术交流会

随着科学技术的飞速发展，半导体材料的革新速度也进一步加快。当前，碳化硅作为第三代半导体材料的典型代表，在新能源汽车、光伏、储能等新兴领域正快速渗透，已成为全球半导体产业的前沿和制高点。同时，我国“十四五”规划已将碳化硅半导体纳入重点支持领域，碳化硅半导体将在我国 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心等新基建领域发挥重要作用。

要充分实现碳化硅功率器件优异的性能，第一步是生长出高质量单晶。而碳化硅的本身特性决定了其单晶生长难度较大——不能采用目前半导体工业主流所采用的生长工艺较成熟的生长法——直拉法、降埚塌法等方法进行生长。在当前倡导节能减排的大趋势下，快速稳定地突破碳化硅单晶尺寸和质量等关键问题，才能够更好地占据未来碳化硅市场。

在此背景下，中国粉体网将在江苏苏州举办第三代半导体 SiC 晶体生长技术交流会，大会将汇聚国内行业专家、学者、技术人员、企业界代表围绕晶体生长工艺、关键原材料、生长设备及应用展开演讲交流。

时间：

2024 年 4 月 25-26 日（24 日全天报到）

同期同址会议：第三届半导体行业用陶瓷材料技术研讨会

地点：

苏州 白金汉爵大酒店（相城店）
苏州市相城区相城大道 1111 号

主办单位：



会议主题：

- 1、SiC 晶体生长技术难点、发展现状
- 2、SiC 晶体生长用装备、仪器及国产化情况
- 3、符合行业要求的高端原料及生产技术
- 4、电动汽车、5G、人工智能等热点应用领域及新兴市场分析

特色活动：

大会征集参会企业相关技术合作、产品采购，工艺方案等需求进行现场采配活动，相关信息将进行展板展示，提高现场沟通交流效率！

征集内容包含但不限于以下几点：

- 1、行业投资、融资需求
- 2、科研成果转化
- 3、产品工艺问题解决方案

4、原料、设备、仪器采购需求

会议费用：

2800 元/人

大会赞助：

（赞助详细内容请联系会务组了解）

- 1、协办赞助（含展位、企业致辞，LED 大屏广告，视频播放，企业报告等）
- 2、晚宴赞助（含展位、晚宴大屏 LOGO 展示、晚宴致辞、主持人口播广告等）
- 3、其它赞助（资料袋、茶歇、椅背广告、胸牌广告赞助等）
- 4、展位展示（展示桌椅+展位背景墙广告）

付款账户：

户名	山东中粉会展服务有限公司
开户行	中国银行股份有限公司临沂北城支行
帐号	233841636876

会务组：

联系人：任经理

联系方式：18660985530（同微信）

